

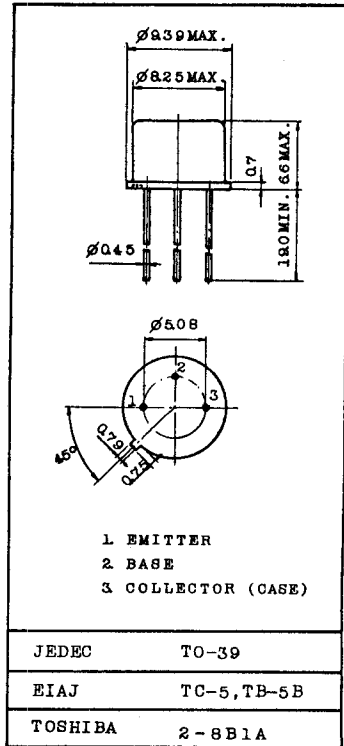
通信工業用
INDUSTRIAL APPLICATIONS

Unit in mm

- 高周波増幅用
- 高速度スイッチング用
 - High Frequency Amplifier Applications
 - High Speed Switching Applications
- スイッチング時間が速い ; $t_{stg} = 60ns$ (Typ.)
- トランジション周波数が高い ; $f_T = 150 MHz$ (Typ.)
- ◡ 耐圧です ; $V_{CBO} = 90V$ (2SC108A)

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース 間電圧	2SC108A	90	V
	2SC109A	70	
コレクタ・エミッタ 間電圧	2SC108A	70	V
	2SC109A	50	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	800	mA
エミッタ電流	I_E	-800	mA
コレクタ損失	P_C	800	mW
温度	T_j	175	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~175	$^\circ C$



* PCT技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

2SC108A

2SC109A

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

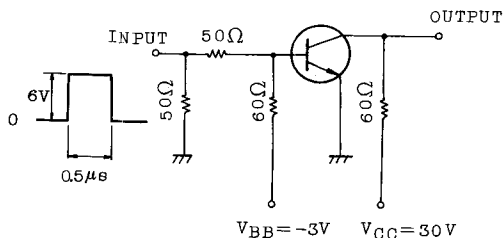
CHARACTERISTIC		SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	2SC108A	I _{CB0}	V _{CB} =80V, I _E =0	-	-	0.5	μA
	2SC109A		V _{CB} =60V, I _E =0				
エミッタシャ断電流		I _{EBO}	V _{EB} =5V, I _C =0	-	-	1.0	μA
直流電流増幅率 (Note)		h _{FE}	V _{CE} =2V, I _C =200mA	40	-	240	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧		V _{CE(sat)}	I _C =200mA, I _B =20mA	-	0.2	0.4	V
ベース・エミッタ間飽和電圧		V _{BE(sat)}	I _C =200mA, I _B =20mA	-	0.8	1.0	
トランジション周波数		f _T	V _{CE} =10V, I _E =-10mA	100	150	-	MHz
コレクタ出力容量		C _{ob}	V _{CB} =10V, I _E =0 f = 1MHz	-	9	15	pF
スイッチング 時間	ターンオン時間	t _{on}	(Fig. 1)	-	30	70	ns
	蓄積時間	t _{stg}		-	60	80	
	下降時間	t _f		-	20	40	

Note ; h_{FE}により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of h_{FE}, the 2SC108A and 2SC109A are classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC108A-R 2SC109A-R	40	80
2SC108A-O 2SC109A-O	70	140
2SC109A-Y	120	240

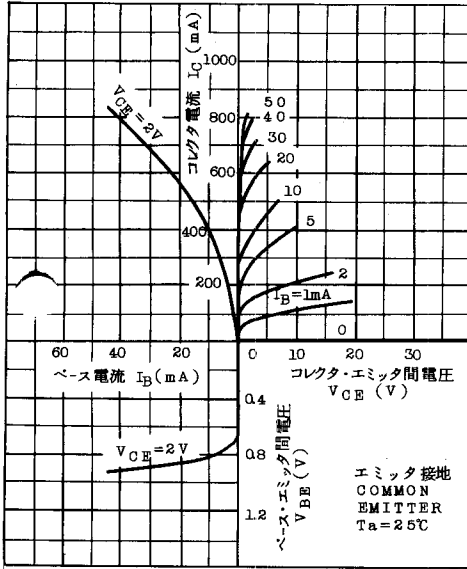
Fig. 1 スイッチング時間測定回路
SWITCHING TIME TEST CIRCUIT



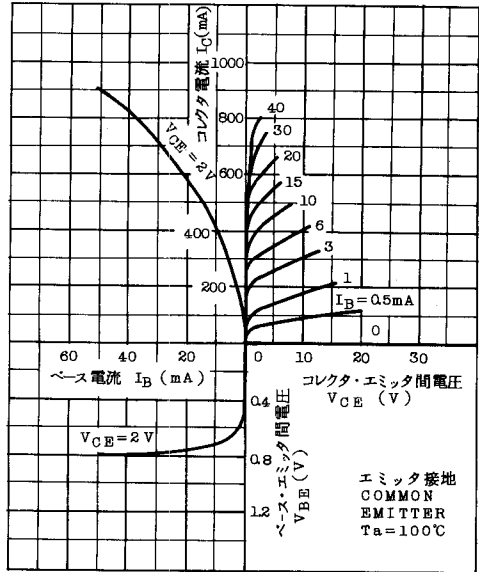
2SC108A

2SC109A

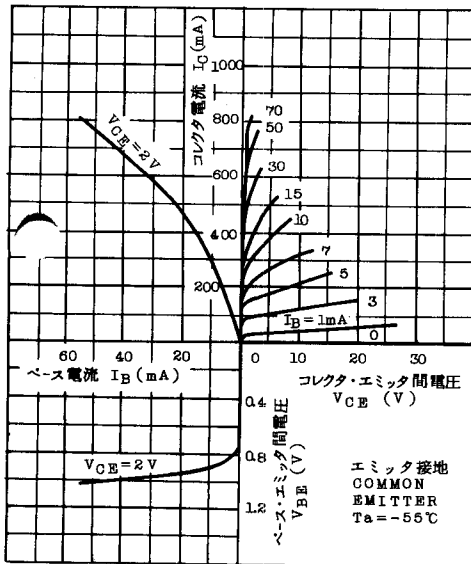
STATIC CHARACTERISTICS



STATIC CHARACTERISTICS

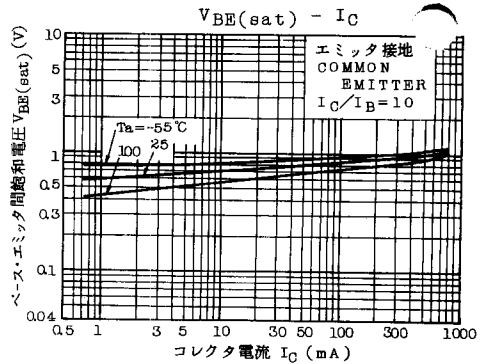
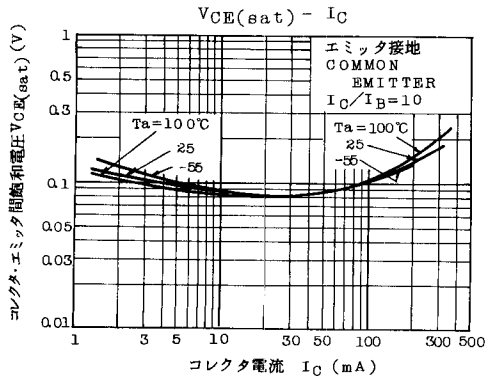
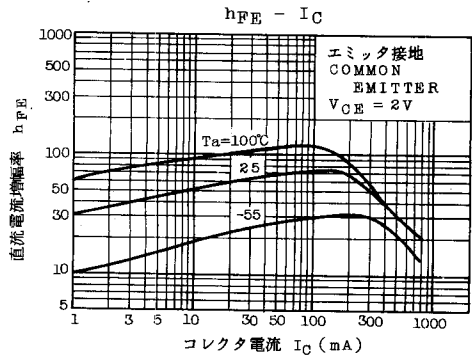
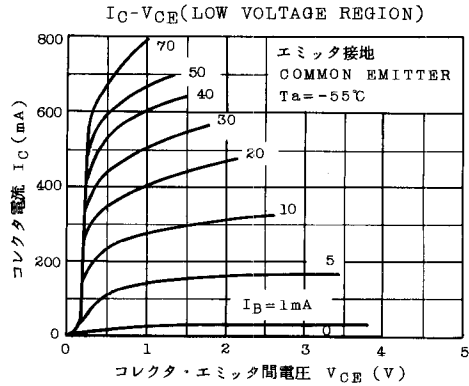
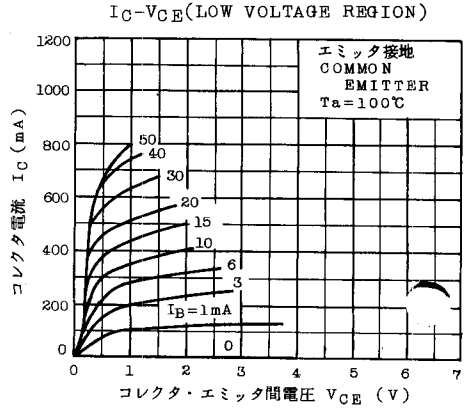
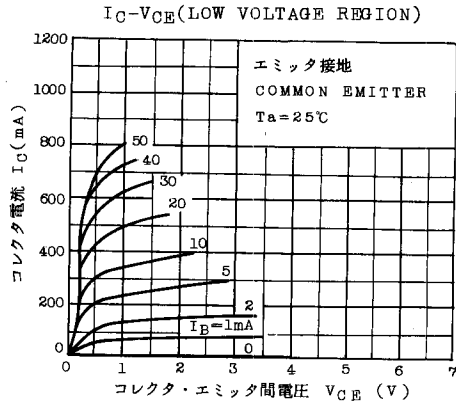


STATIC CHARACTERISTIC



2SC108A

2SC109A



2SC108A 2SC109A

